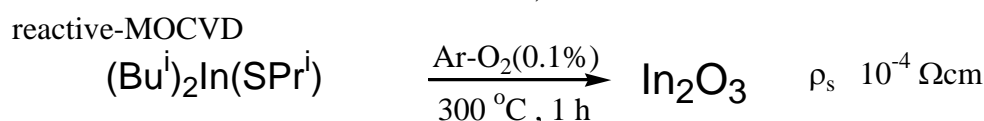
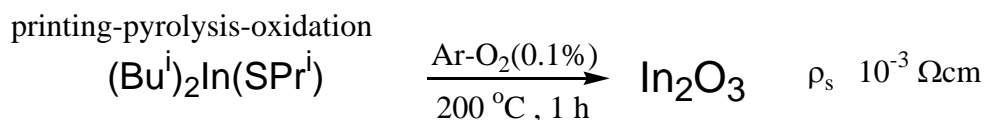
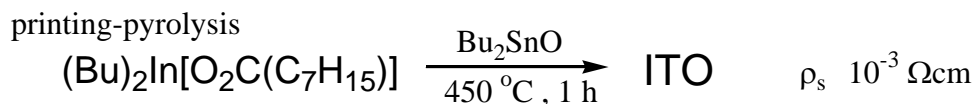


(2) ソフトエネルギープロセスによる半導体, エレクトロニクスセラミックス製造法開発

— 可能な限りエネルギーを消費しない薄膜や微粒子の製造法 —

-1 酸化インジウム薄膜 (In_2O_3 , ITO) — シングルソース前駆体 —

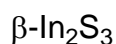


Polyhedron **1987**, 6, 507; **1989**, 8, 763; *Thin Solid Films* **1988**, 167, L27; *J. Polym. Sci. Part A* **1992**, 30, 153; *J. Electrochem. Soc.* **1991**, 138, 631; *J. Mater. Chem.* **1994**, 4, 51.

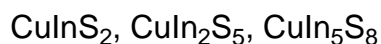
-2 金属硫化物薄膜

— シングルソース前駆体 —

CVDによる二元・三元化合物半導体薄膜成長



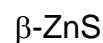
Thin Solid Films **1991**, 198, 339.



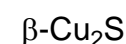
Chem. Lett. **1988**, 1849; *Thin Solid Films* **1992**, 209, 145; *J. Mater. Chem.* **1992**, 2, 765; *Appl. Organomet. Chem.* **1992**, 6, 685.



Bull. Chem. Soc. Jpn. **1989**, 62, 939; *Thin Solid Films* **1991**, 195, L1.



Thin Solid Films **1995**, 271, 4; **1999**, 342, 108.



Ind. Eng. Chem. Res. **1989**, 28, 877; *Adv. Mater. CVD* **1996**, 2, 174.



Trans. Mater. Res. Soc. Jpn. **2001**, 26, 1283; **2003**, 28, 1287.

有機反応を利用した温和な条件での金属硫化物ナノ粒子製造



Trends Inorg. Chem. **1991**, 2, 79; *J. Mater. Chem.* **1995**, 4, 1761; *Proc. 4th ICMC* **1999**, P69; *Trans. Mater. Res. Soc. Jpn.* **1999**, 24, 627; *Proc. 7th SPACC Symp.* **2000**, 23